# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-299046

(43) Date of publication of application: 11.10.2002

(51)Int.Cl.

H05B 33/06 H05B 33/14 H05B 33/26

(21)Application number: 2001-099939

(71)Applicant : PIONEER ELECTRONIC CORP

02.08.2006

(22)Date of filing:

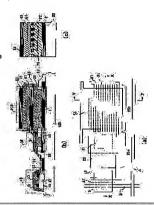
30.03.2001

(72)Inventor: TSUCHIDA MASAMI

# (54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE UNIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an active matrix type organic electroluminescence unit which is easy to manufacture. SOLUTION: This organic electroluminescence unit is composed of an organic material laver, formed on a surface of an electrode panel, a dielectric layer formed in the vicinity of the organic material layer of the surface of the electrode panel, a metal electrode continuously formed on a surface of the organic material layer and the dielectric layer, and forming a part corresponding to the organic material layer as a control electrode, and an organic electroluminescence element formed on the organic material laver.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

١

# (12)公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号 特開 2002 — 299046

(P2002-299046A) (43)公開日 平成14年10月11日(2002.10.11)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI			テーマコート	' (参考)
H05B 33/06		H05B 33/00	;		3K007	
G09F 9/30	338	G09F 9/30	) ;	338	5C094	
	365		:	365 2	5F102	
HO1L 29/786		H05B 33/14	1		A 5F110	
29/80		33/20	6	2	Į.	
	審査請求	未請求 請求	対項の数4 C	DL (全	6 頁) 最終	頁に続く
(21)出願番号	特願2001-99939(P2001-99939)	(71)出願人 000005016				
			パイオニア	株式会社		
(22)出願日	平成13年3月30日(2001.3.30)	東京都目黒区目黒1丁目4番1号				
		(72)発明者				
			埼玉県鶴ケ	島市富士見	16丁目1番1	号パ
			イオニア株式会社総合研究所内			
		(74)代理人	(74)代理人 100079119			
			弁理士 藤	村 元彦		

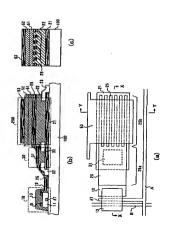
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネセンスユニット

## (57) 【要約】

【課題】 製造が容易なアクティブマトリクス型の有機 エレクトロルミネセンスユニットを提供することを目的 とする。

【解決手段】 電極パネルの表面に形成された有機材料 層と、電極パネルの表面の前面有機材料層の近傍に形成 された誘電体層と、上配有機材料層と誘電体層との表面 に連続して形成され、上配有機材料層に対応する部分は 制御電極になっている金属電極と、上配有機材料層に形 板であっている金属電板と、上配有機材料層に形 構成される。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示パネルの画素を担う有機エレクトロ ルミネセンスユニットであって、

#### 雷極パネルと、

前記電極パネルの表面に形成された有機材料層と、

前記雷極パネルの表面の前記有機材料層の近傍に形成さ れた誘雷体層と、

前記有機材料層と前記誘雷体層との表面に連続して形成 されて前記有機材料層に対応する部分は制御電板になっ ている金属電極と、

前記有機材料層上に形成されている有機エレクトロルミ ネセンス素子と、からなることを特徴とする有機エレク トロルミネセンスユニット。

【請求項2】 前配制御電極は格子状の電極であること を特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネセン スユニット。

【請求項3】 前記制御雷極が前記有機材料層に埋設さ れていることを特徴とする請求項1記載の有機エレクト ロルミネセンスユニット。

前記走査ライン各々に交叉する複数のデータラインを有

前記走香ラインに印加された電圧に広じて前記データラ インに印加された電圧を前記金属電極に印加するトラン ジスタを更に備えたことを特徴とする請求項1記載の有 機工レクトロルミネセンスユニット。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明はアクティブマトリク ス型表示パネルの各画素を担う有機エレクトロルミネセ 30 ンスユニットに関する。

#### [0002]

【従来の技術】現在、発光素子をマトリクス状に配置し て構成される表示パネルを用いたマトリクス型ディスプ レイの開発が広く進められている。このような表示パネ ルに用いられる発光素子としては、例えば、有機材料を 発光層として用いたエレクトロルミネセンス素子(以 下、有機EL素子と称する)がある。この有機EL素子

を用いたマトリクス型の表示パネルとして、単純マトリ クス型表示パネルと、アクティブマトリクス型表示パネ 40 ルとが知られている。アクティブマトリクス型表示パネ ルは単純マトリクス型表示パネルに比べて、低消費電力 であり、また画素間のクロストークが少ないなどの利点 を有し、特に大画面ディスプレイや高精細度ディスプレ イに適している。

【0003】図1は、このようなアクティブマトリクス 型表示パネルの構成を示す図である。図1に示す如く、 かかる表示パネルには、表示パネルを駆動すべき電源電 位Vcが印加されている陽極電源パスライン16、及び 接地電位GNDが印加されている陰極電源パスライン1 50 電圧によりFET20のゲートGには引き続き電圧印加

7が形成されている。更に、表示パネルには、1画面の n個の水平走杏ライン各々を担う走杏ライン(金属電板)  $A_1 \sim A_0$ と、各陰極線に交叉して配列されたm個のデー タラインB. ~ B. とが形成されている。これら走査ライ ンA、~A。及びデータラインB、~B。の交差部に、画素 を担う有機ELユニットE, 、~E。 が形成されてい る.

【0004】図2は、1つの走査ラインA及びデータラ インBの交差部に形成されている有機ELユニットEの 10 回路構成の一例を示す図である。図2において、走査ラ イン選択用のFET (Field Effect Transistor) 1 0 の ゲートGには走査ラインAが接続され、そのドレインD にはデータラインBが接続されている。FET10のソ ースSには発光駆動用トランジスタとしてのFET20 のゲートGが接続されている。FET20のソースSに は陽極電源パスライン16を介して電源電位Vcが印加 されており、そのゲートG及びソースS間にはキャパシ タ30が接続されている。更に、FET20のドレイン Dには有機EL素子50のアノード端が接続されてい 【請求項4】 前記表示パネルは、複数の走査ラインと 20 る。有機EL素子50のカソード端には、陰極電源パス ライン17を介して接地重位GNPが印加されている。 【0005】次に、発光駆動制御回路(図示せぬ)によっ て為される有機ELユニットEの駆動動作について述べ る。先ず、発光駆動制御回路は、表示パネルの走査ライ ンA. ~A. 各々に順次、択一的に走査パルスを印加して 行く。更に、発光駆動制御回路は、各走査パルスの印加 タイミングに同期させて、各水平走査ライン毎の入力映 像信号に基づく画素データパルスDP。~DP。各々を生 成してデータラインB、~B。に夫々印加する。この際、 走査パルスの印加されている走査ラインAに接続されて いる有機ELユニットEの各々は、後述する画素データ の書込対象となる(以下、走査選択状態と称する)。走査 選択状態となった有機ELユニットEのFET10は、 上記走査パルスに応じてオン状態となり、データライン Bを介して供給された画素データパルスDPに基づく電 圧をFET20のゲートG及びキャパシタ30に夫々印 加する。かかる画素データパルスDPに基づく電圧印加 に応じてFET20はオン状態となり、上記電源質位V cに基づく発光起動電流を有機EL素子50に流す。か かる発光起動電流に応じて有機EL素子50は発光す る。この間、キャパシタ30は、上記画素データバルス DPに基づく電圧印加に応じて充電される。かかる充電 動作により、キャパシタ30には、上記画素データに応 じた電圧が保持され、いわゆる画素データの書き込みが 為される。

【0006】ここで、上記走査選択状態から開放される と、FET10はオフ状能となり、FET20のゲート Gに対する画素データパルスDPの供給を停止する。し かしながら、前述した如くキャパシタ30に保持された が為されてFET20はオン状態を維持し、発光起動電 流を有機EL素子50に流しつづける。すなわち、上記 走査選択状態からの開放後も有機EL素子50は、発光 を継続するのである。

【0007】このように、アクティブマトリクス型表示 パネルの各画素を担う有機ELユニットEには、発光素 子としての有機EL素子50の他に、走査ライン選択用 のトランジスタ(FET10)、発光駆動用のトランジス タ(FET20)、及び画素データ保持用のキャパシタ3 0が形成されている。現在、かかる有機ELユニットE 10 を図1に示す如くマトリクス状に配列した表示パネルを 製造するにあたり、上記FET10、20、及びキャパ シタ30各々に対してはTFT(Thin Film Transistor) 製造プロセスを用いる。一方、有機EL素子50に対し ては有機EL製造プロセスを用いてその製造を行ってい

【0008】従って、FET10及び20を製造するプ ロセスと、有機EL素子50を製造するプロセスとが全 く異なる為、全体の製造プロセスが複雑になるという問 題があった。この際、FET10及び20を共に有機材 20 料を用いたトランジスタで構築させることも考えられ る。しかしながら、有機材料の電子移動度はシリコン半 遊体に比して低い為、特に、発光駆動用のFET20を 有機トランジスタで構築した場合に、有機EL素子を十 分な輝度で発光させる駆動電流が得られないという問題 が生じる。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる問題 を解決せんとして為されたものであり、製造が容易なア クティブマトリクス型の有機エレクトロルミネセンスユ 30 ニットを提供することにある。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明によるアクティブ マトリクス型有機エレクトロルミネセンスユニットは、 表示パネルの画素を担う有機エレクトロルミネセンスユ ニットであって、電極パネルと、前記電極パネルの表面 に形成された有機材料層と、前記電極パネルの表面の前 記有機材料層の近傍に形成された誘電体層と、前記有機 材料層と前記誘電体層との表面に連続して形成されて前 記有機材料層に対応する部分は制御電極になっている金 40 属電極と、前記有機材料層上に形成されている有機エレ クトロルミネセンス素子と、からなる。

#### [0011]

【発明の実施の形態】本発明の実施例を図面を参照しつ つ詳細に説明する。図3は、本発明によるアクティブマ トリクス型有機エレクトロルミネセンスユニット(以 下、単に、有機ELユニットと称する)の構造を示す図 である。尚、図3(a)は、この有機ELユニットを上面 からみた図であり、図3(b)は図3(a)中のX-X線に 断面を夫々示す図である。又、かかる有機ELユニット は、図1に示す如きアクティブマトリクス型表示パネル の有機ELユニットEに相当するものであり、その電気 回路構成も図2に示す如きものと同一である。即ち、図 2に示す如き走査ライン選択用のFET10、画素デー 夕保持用のキャパシタ30、発光駆動用のFET20及 び有機 F.I. 表子 5.0 各々の機能が、図 3(a)~図 3(c) に示す如き構造にて製造されるのである。

【0012】図3(b)に示す如く、诱光性のガラス等か らなる基板100上には、上記FET10を担う絶縁膜 11、金属電極12、及び、例えばポリチオフェン(Pol vthiophene)等からなる有機材料層13が形成されてい る。又、表示パネルの走査ラインAには、データライン Bとの各交叉部の近傍位置において、図3(a)に示す如 くこのデータラインBと平行した方向に伸張する突起雷 極部ATが設けられている。絶縁膜11は、この突起電 極部ATを覆うように基板100 上に形成されており、 その表面上には金属電板12及びデータラインBが夫々 形成されている。金属電板12は、図3(a)に示す如 く、上記データラインB及び突起電極部ATと平行した 方向に伸長して蒸着形成されている。この際、上記デー タラインBがFET10のドレイン電極、金属電極12 がソース電板、突起電板部ATがゲート電板となる。 又、図3(b)に示す如き有機材料層13内における金属 電板12及びデータラインBに挟まれた領域に、FET 10としてのチャンネルが形成される。これにより、走 査ラインAを介してFET10のゲート電極としての突 起電極部ATに走査パルスが印加されると、FET10 がオン状態となり、ドレイン電極としてのデータライン B及びソース電極としての金属電板12間に電流が流れ る。よって、上記走査パルスの印加に応じて、データラ インBを介して供給された画素データに対応した電圧が 金属電板12に印加されることになる。

【0013】又、基板100上には、図3(a)及び図3 (b)に示す如き形態にて、透明電極21が形成されてい る。透明電板21は、図1に示す如き表示パネルの陽板 電源バスライン16に接続されており、この陽極電源バ スライン16を介してパネル駆動用の電源電位Vcが印 加されている。透明電極21の表面には、図3(b)に示 すように、誘電体層31、絶縁膜32、絶縁膜33、有 機材料層22及び絶縁膜23が形成されている。絶縁膜 22、32及び33は、不要な短絡を防止すべく設けら れたものである。誘電体層31は、高分子の有機材料か らなる誘電体であり、有機材料層22は、例えばポリチ オフェン(Polythiophene)等の有機材料である。有機材 料層22内に埋設されると共に、誘電体層31の表面及 びFET10の金属電板12各々に接触するように、共 通金属電極25が図3(a)及び(b)に示す如く伸長して 蒸着形成されている。尚、共通金属電極25は、図3 おける断面、図3(c)は図3(a)中のY-Y線における 50 (a)に示す如く、板状の板状電極部25a及び格子状の 格子状質極部25 bからなる。この際、共涌金属電極2 5の格子状質極部25bは、図3(c)に示す如く有機材 料層22内に埋設されている。かかる構成により、後述 する有機ELトランジスタ250のゲートが構築され る。一方、共通金属電極25の板状電極部25aは、図 3(b)に示す如く誘電体層31の表面上に接触し、更 に、FET10の金属雪極12に接触するように伸張し て形成されている。有機材料層22の表面上には、有機 E L 素子50として作用する有機正孔輸送層51及び有 機発光層 5 2 の各々が図 3 (b) 及び図 3 (c) に示す如く 積層されている。更に、この有機発光層52の表面には 陰極53が蒸着形成されている。陰極53は、図1に示 す如き表示パネルの陰極電源パスライン17に接続され ており、この陰極電源パスライン17を介して接地電位 GNDが印加されている。

【0014】ここで、上記誘電体層31と、この誘電体 層31を図3(b)に示す如く挟む共通金属電概25の板 状電極部25a及び透明電極21にて、図2に示す如き キャパシタ30が形成される。すなわち、共通金属電板 25の板状電極部25aがキャパシタ30の一端の電極 20 を担い、透明電極21がキャパシタ30の他端の雷極を 担うのである。

【0015】又、図3(b)に示す如き、透明電極21、 有機材料層22、共通金属電極25の格子状電極部25 b、有機正孔輸送層51、有機発光層52及び陰極53 なる構造により、図2に示す如き発光駆動用のFET2 0及び有機EL素子50各々の機能を併せ持つ有機EL トランジスタ250を形成している。この際、透明電極 2 1 が発光駆動用トランジスタのソース質極を担うと共 に、共通金属電極25の格子状電極部25bが上記発光 30 駆動用トランジスタのゲート電極を担う。又、陰板53 が発光駆動用トランジスタのドレイン側の電極と有機E L素子のカソード端を兼ねている。

【0016】以上の如き構造を有する有機ELトランジ スタ250では、上記共通金属電極25に印加された電 圧に応じた駆動電流が図3(a)及び(c)に示す如き共通 金属電極25の格子状電極部25bの格子間を介して透 明電極21及び陰極53間に流れる。この際、有機発光 層52は、上記駆動電流に応じた輝度で発光する。この ように、有機ELトランジスタ250は、図3(b)に示 40 す如き透明電極21及び陰極53間、つまり基板100 に対して垂直方向に雷流を流す構造を採用している。よ って、透明電極21及び陰極53間を移動する電子の通 過面積、いわゆるチャンネル面積を広くできると共にそ の移動距離を短くすることが可能になる。これにより、 電子移動度がシリコン半導体に比して低い有機材料を用 いたトランジスタであっても、有機EL素子を十分な輝 度で発光し得る駆動電流が得られるようになる。従っ て、図3(a)~図3(c)に示す有機ELユニットによれ

ジスタをも有機材料で構築することが可能となる。

【0017】更に、かかる有機ELユニットでは、透明 質極21の表面に誘雷体層31及び有機材料層22各々 を近接して形成する。そして、共通金属電極25の格子 状質極部25bを有機材料層22に埋設させることによ り発光駆動用トランジスタの制御電極(ゲート電極)を構 築すると共に、共通金属電極25の板状電極部25aを 誘電体層31の表面に形成することによりキャパシタ3 0を構築している。従って、共涌金属電極25の1回分 の蒸着作業により、発光駆動用トランジスタのゲート機 築及び画素データ保持用キャパシタの形成が同時に為さ れるようになる。

【0018】尚、上記実施例においては、発光駆動用ト ランジスタの構造として、図3(c)に示す如き、有機材 料層22に共通金属電極25の格子状電極部を埋設させ ることによりゲートを形成するSIT(Static induction n transistor)構造を採用しているが、かかる構成に限 定されるものではない。例えば、n型の有機材料からな るn型有機材料層を、p型の有機材料からなるp型有機 材料層にて縦型に挟んで積層したバイボーラ構造のトラ ンジスタを上記発光駆動用トランジスタとして採用して も良く、あるいはサイリスタ構造を採用しても良い。要 するに、発光駆動用トランジスタとしては、チャンネル 面積を広くして電流駆動能力を高めるべく、基板100 に対して垂直方向に電流を流す縦型構造のトランジスタ を採用したものであれば、他のトランジスタ構造を採用 しても構わないのである。この際、図3(b)に示すよう に、発光駆動用トランジスタと有機EL素子との雷極を 共有させて両者を一体成形するようにしても良いし、あ るいは、両者を個別に形成して縦方向に重ねるようにし ても良い。

【0019】又、上記実施例においては、走査ライン選 択用のトランジスタであるFET10としては、図3 (b)に示す如き、データラインB及び金属電板12間に おいて電流を流す、いわゆる横型構造のトランジスタを 採用している。しかしながら、この走査ライン選択用の トランジスタに関しても、発光駆動用トランジスタと同 様に縦型構造のトランジスタを採用しても良い。 [0020]

【発明の効果】上記したことから明らかなように、本発 明においては、発光駆動用のトランジスタとして縦型構 造のトランジスタを採用することにより、有機 E.I. 妻子 のみならず発光駆動用のトランジスタをも有機材料で構 築可能にしている。更に、本発明においては、電極パネ ルの表面に誘電体層及び有機材料層各々を互いに近接し て形成させる。そして、共通金属電極の格子状電極部を 有機材料層に埋設して両者を接触させることにより発光 駆動用トランジスタのゲートを構築すると共に、共通金 属電極の板状電極部を誘電体層の表面に形成することに ば、有機EL素子50のみならず、発光駆動用のトラン 50 より画素データ保持用キャパシタを構築している。よっ て、共通金属電極の1回分の蒸着作業により、発光駆動 用トランジスタのゲート構築及び画素データ保持用キャ パシタの形成が同時に為されるようになる。

【0021】よって、本発明によれば、アクティブマト リクス駆動を担うトランジスタ及びキャパシタを含む有 機ELユニットを、容易に製造することが可能となる。 【図面の簡単な説明】

【図1】アクティブマトリクス型表示パネルの一例を示

す図である。 【図2】アクティブマトリクス型表示パネルの各画素を 10 52 有機発光層

担う有機ELユニットEの電気回路を示す図である。

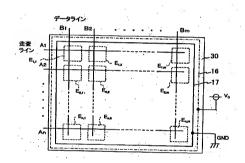
【図3】本発明による有機ELユニットの構造を示す図

である。

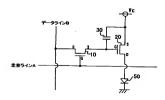
【主要部分の符号の説明】

- 10.20 FET
- 21 透明電極
- 22 有機材料層
- 25 共通金属電極
- 30 キャパシタ
- 31 誘電体層
- 50 有機EL表子
- 5.3 除極

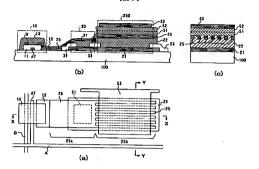
[図1]



[図2]



[図3]



## フロントページの続き

(51) Int. C1. 7

識別記号

FI -

H05B 33/14

33/26

H01L 29/78 29/80

618

Fターム(参考) 3K007 AB18 BA06 BB07 CB01 CB02 DA01 DB03 EB00 FA02 GA04

5C094 AA07 AA43 BA03 BA27 CA19

DA13 DB01 DB04 EA04 EA05 EA10 EB02 FA01 FA02 FB01

FB14 GB10

5F102 FA10 FB01 FB10 GA11 GA16 GC08 GL10 GS10

5F110 AA16 BB01 CC03 DD02 GG05 HK32 NN71 NN72